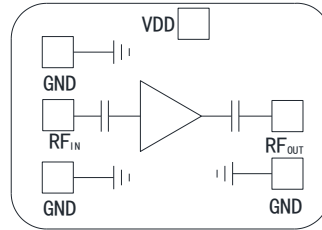


特点:

- 频率范围: 5.0~18.0GHz
- 增益: 典型值 32.0dB
- 噪声系数: 典型值 1.6dB
- 1dB 压缩点输出功率: 典型值+18.0dBm
- GaAs 裸片
- 芯片尺寸: 1.85×0.94×0.1mm

功能框图:



产品简介:

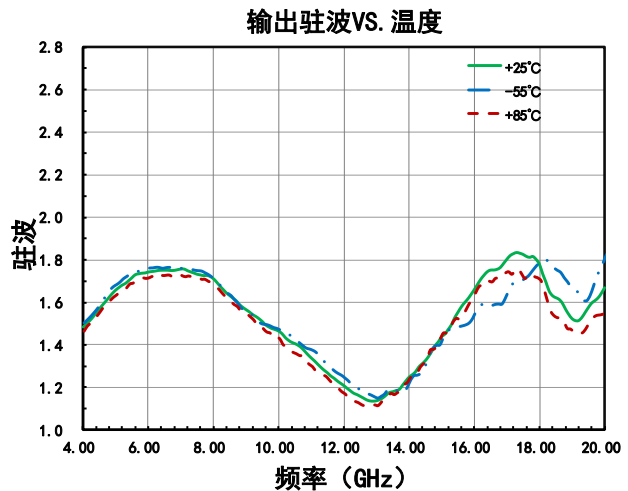
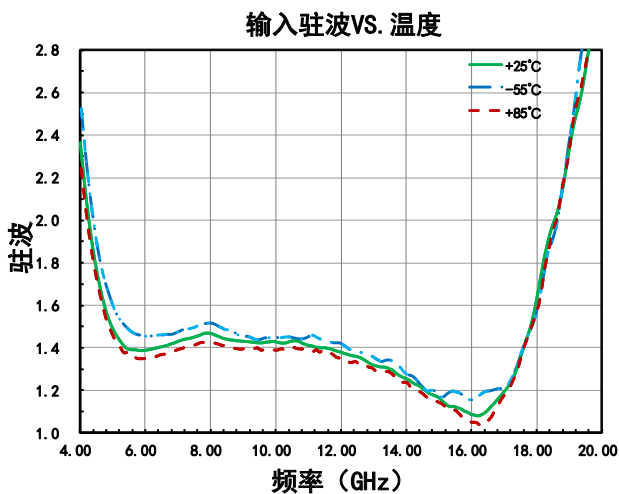
YDC1163 是一款采用 GaAs pHEMT 工艺设计制造的低噪声放大器芯片。该芯片采用了片上金属化通孔工艺保证良好接地。芯片背面进行了金属化处理, 适用于导电胶粘接或共晶烧结工艺, 芯片均经过在片 100% 直流与 RF 测试。

性能参数: (50Ω 系统)

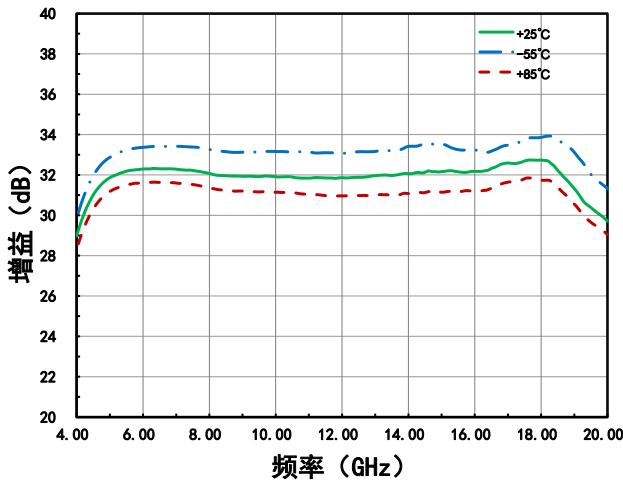
参数名称	符号	测试条件	参数值				单位	备注
			常温 (+25℃)			全温		
			MIN	TYP	MAX	-55℃~+85℃		
频率范围	f	V _D =+5.00V f=5.0~18.0GHz P _{IN} =-30dBm	5.0	-	18.0	5.0~18.0	GHz	-
增益	G		31.0	32.0	33.5	30.5~34.5	dB	-
增益平坦度	ΔG		-	1	2	≤4	dB	-
输入驻波比	VSWR _I		-	1.4:1	1.8:1	≤2.0:1	-	-
输出驻波比	VSWR _O		-	1.6:1	2.0:1	≤2.0:1	-	-
噪声系数	NF		-	1.6	2.0	≤2.5	dB	-
反向隔离度	I _R		40	55	-	≥40	dB	-
1dB 压缩点输出功率	OP _{1dB}	V _D =+5.00V	+16.5	+18.0	-	≥+16.5	dBm	-
输出三阶截点 ^①	OIP ₃	f=5.0~18.0GHz	+26	+30	-	-	dBm	-
电源电压	V _D	-	+4.75	+5.00	+5.25	+4.75~+5.25	V	功能正常
工作电流	I _D	V _D =+5.00V, P _{IN} =-30dBm	-	80	90	≤100	mA	静态电流

①输出三阶截点测试条件: 双音信号间隔 1MHz, 单音信号功率 0dBm。

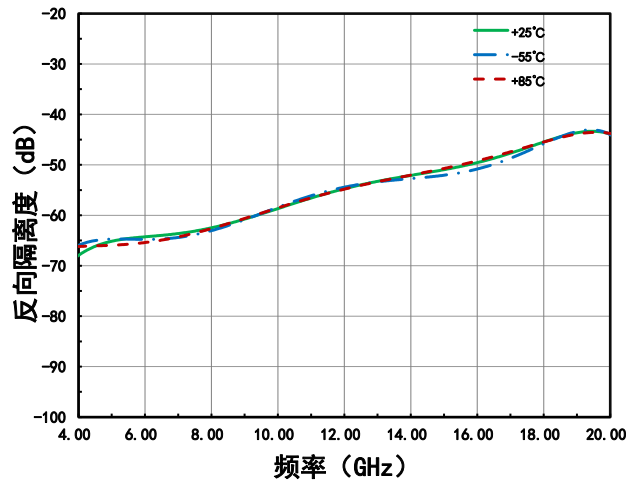
典型测试曲线: (50Ω 系统, V_D=+5.00V)



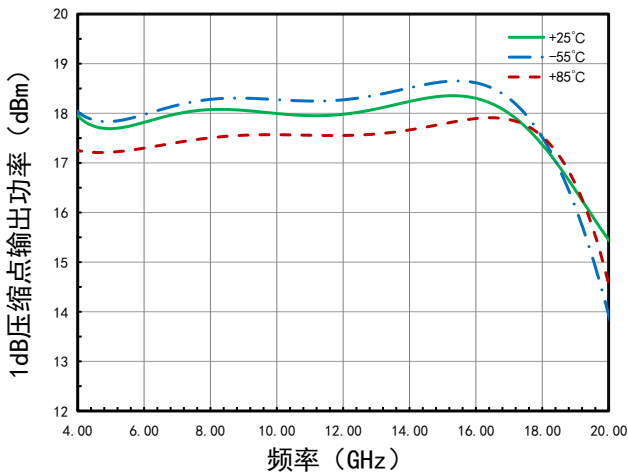
增益VS. 温度



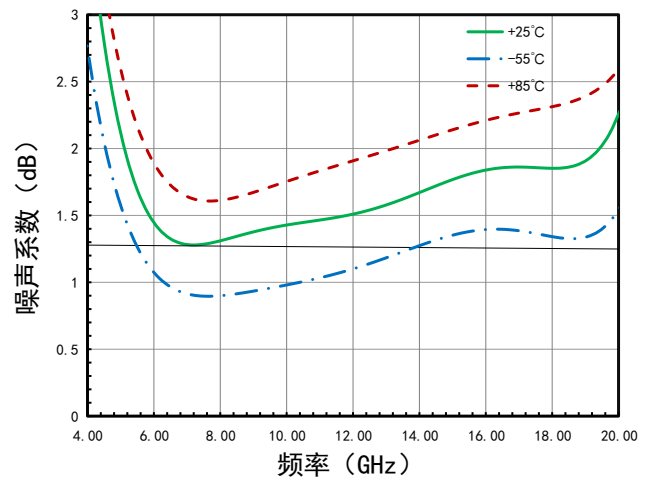
反向隔离度VS. 温度



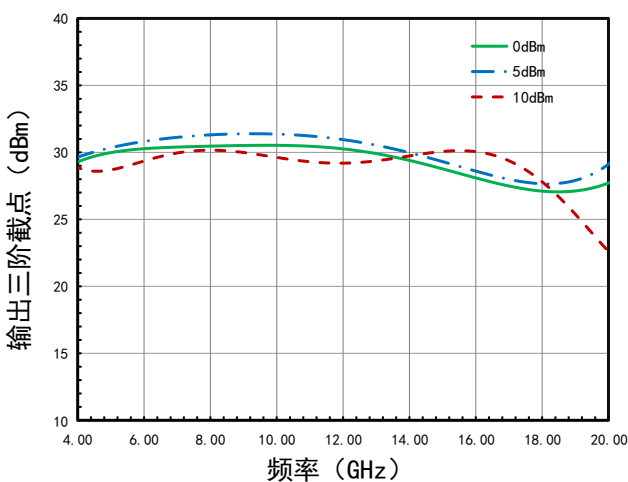
1dB压缩点输出功率VS. 温度



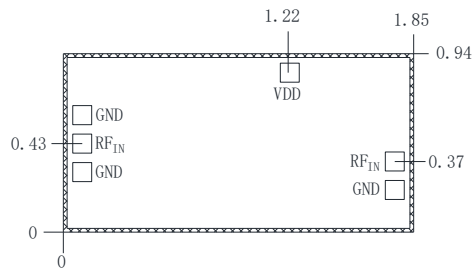
噪声系数VS. 温度



输出三阶截点VS. 频率(+25°C)



外形尺寸图:

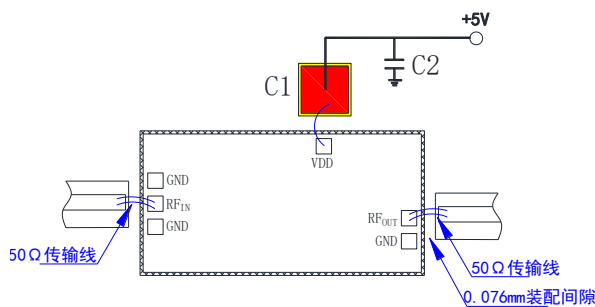


注: 1.单位: mm;

- 2.芯片背面镀金, 背面接地;
- 3.键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1 \times 0.1\text{mm}$;
- 4.外形尺寸公差: $\pm 0.05\text{mm}$ 。



推荐装配图:



注: 射频端口应尽量靠近微带线以缩短键合金丝尺寸, 典型的装配间隙是 $0.076\sim 0.152\text{mm}$, 使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合, 建议金丝长度 $250\sim 400\mu\text{m}$ 。

产品使用注意事项:

1. 本芯片产品需要在干燥、氮气环境中存储, 在超净环境装配使用。
2. 裸芯片使用的砷化镓材料较脆, 芯片表面容易受损, 不能用干或湿化学方法清洁芯片表面使用时必须小心。
3. 芯片粘接装配时, 需考虑热膨胀应力对芯片的影响, 芯片建议烧结或粘在热膨胀系数相近的载体上, 如可伐、钨铜或钼铜垫片上, 避免热膨胀应力匹配不当导致芯片开裂。
4. 芯片使用导电胶或合金烧结 (合金温度不能超过 300°C , 时间不能超过 20 秒), 使之充分接地。
5. 芯片射频端口使用 $25\mu\text{m}$ 双金丝键合, 建议金丝长度 $0.25\sim 0.40\text{mm}$ ($10\sim 16\text{ mils}$)。
6. 存储和使用过程中注意防静电, 烧结、键合台接地良好。

引脚定义:

符号	描述
RF _{IN}	射频输入, 内部有隔直
RF _{OUT}	射频输出, 内部有隔直
VDD	电源端口, +5.00V 供电
GND	接地
芯片背面	接地

极限参数表:

参数名称	极限值
输入射频功率	+20dBm
电源电压	+8V
装配温度	+300°C, 20s
工作温度	-55°C~+85°C
贮存温度	-55°C~+150°C
静电放电敏感度等级	1A

超过以上任何一项极限参数, 可能造成器件永久损坏。

推荐电路值:

位号	推荐值/推荐型号	备注
C1	100pF	
C2	10nF	